

北京航空航天大学优秀研究生申请表

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|-----------|----|-----|------|---------|----|---|
| 姓名 | 王朝 | 学号 | BY1902066 | 性别 | 男 | 政治面貌 | 团员 | | |
| 专业 | 微电子学与固体电子学 | | | 导师 | 张有光 | 入学年月 | 2019年9月 | 民族 | 汉 |
| 在读期间的思想政治表现 | 过去一年中所在党（团）支部共举办支部活动____次，参加____次，缺席____次。 | | | | | | | | |
| | 党（团）支部书记签字 _____ 年 月 日 | | | | | | | | |
| 指导主任（副书记）签字 _____ 年 月 日 | | | | | | | | | |
| <p>主要申请理由（简述）</p> <p>1、研究生期间成绩单（另附）</p> <p>2、在读期间主要工作成绩（根据申报类别重点表述）</p> <p>本人在读期间的主要研究方向是自旋器件建模、非易失性存算一体电路设计与自旋存储器件芯片设计。以第一作者发表 SCI 论文 2 篇；国际会议论文 3 篇，其中 2 次口头汇报；参与 130nm 工艺 MPW 流片 1 次、Full Wafer 流片 1 次，14nm FinFET 工艺 MPW 流片 1 次。当前 1 篇 SCI 论文、1 篇会议论文在审；一项发明专利在审；参与北京市科学技术委员会“自旋协同矩存储器及其存算一体架构研制”课题，为存算一体架构的核心研制人员。</p> <p>3、获奖情况</p> <p>2019 级学业奖学金一等奖</p> <p>4、其他</p> <p>[1] 论文名称 Compact Model of Dzyaloshinskii Domain Wall Motion-Based MTJ for Spin Neural Networks DOI: 10.1109/TED.2020.2985115 作者 Chao Wang, Zhaohao Wang, Min Wang, Xueying Zhang, Youguang Zhang, and Weisheng Zhao 刊物名称、年、卷、期号 IEEE Transactions on Electron Devices, VOL. 67, NO. 6, JUNE 2020 期刊类型 SCI 检索 IF: 2.913 JCR: Q2 2019</p> <p>[2] 论文名称 Design of an Area-efficient Computing in Memory Platform based on STT-MRAM DOI: 10.1109/TMAG.2020.3016741 作者 Chao Wang, Zhaohao Wang, Gefei Wang, Youguang Zhang, Weisheng Zhao 刊物名称、年、卷、期号 IEEE Transactions on Magnetism, 14 August 2020 (Early Access) 期刊类型 SCI 检索 IF: 1.626 JCR: Q3 2019</p> <p>[3] 论文名称 Computing-in-Memory Architecture Based on Field-Free SOT-MRAM with Self-Reference Method DOI: 10.1109/ISCAS45731.2020.9180668. 作者 Chao Wang, Zhaohao Wang, Gefei Wang, Youguang Zhang, and Weisheng Zhao 会议名称 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Sevilla, 2020, pp. 1-4 会议类型 A 级 EI 硬件领域最新成果汇集，学术水平较高</p> <p>[4] 论文名称 Advanced Spin Orbit Torque Magnetic Random Access Memory with Field-Free Switching Schemes (Invited) DOI: 10.1109/ICSICT49897.2020.9278375 作者 Chao Wang, Zhaohao Wang, Shouzhong Peng, Youguang Zhang, and Weisheng Zhao 会议名称 2020 IEEE 15th International Conference on Solid-State & Integrated Circuit Technology (ICSICT), Kunming, 2020, pp. 1-4 会议类型 B 级 EI ISTP 半导体器件领域的优秀会议</p> <p>[5] 论文名称 Design and Optimization of an Area-efficient SOT-MRAM DOI: 10.1109/EDSSC.2019.8754166 作者 Chao Wang, Zhaohao Wang, Bi Wu, and Weisheng Zhao 会议名称 2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), Xi'an, China, 2019, pp. 1-3</p> | | | | | | | | | |

会议类型 B 级 EI ISTP 半导体器件领域的优秀会议

[6] 论文名称 Field-Free 3T2SOT MRAM for Non-Volatile Cache Memories DOI:
10.1109/TCSI.2020.3020798

作者 Bi Wu, **Chao Wang**, Zhaohao Wang, Ying Wang, Deming Zhang, Dijun Liu et al.

刊物名称、年、卷、期号 IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 67, no. 12,
pp. 4660-4669, Dec. 2020

论文类型 SCI 检索 IF: 3.318 , JCR: Q2 , 2019

本人签字

王朝

2020 年 12 月 23 日

注：该表最长不超过 2 页，A4 纸正反面打印。发表论文必须注明发刊号、发表日期，否则按没有发表处理。
发表论文以及获奖情况另附复印件。在读期间主要工作成绩一栏：申请者主要填写符合相关奖项的成绩及事迹。